

Presupuesto	
Número de pieza	RQ5A030APTL
Fabricante	LAPIS Semiconductor
Descripción	MOSFET P-CH 12V 3A TSMT3
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	6332 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	1V @ 1mA
Vgs (Max)	-8V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TSMT3
Serie	-
RDS (Max) @Id, Vgs	62 mOhm @ 3A, 4.5V
La disipación de energía (máximo)	1W (Ta)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	SC-96
Temperatura de funcionamiento	150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 6V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Tipo FET	P-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	12V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	3A (Ta)

en:

  RQ5C020TPTR ROHM RQ5C020TPTR ROHM	  RQ5A025ZP ROHM RQ5A025ZP ROHM	  RQ5A030AP MOS ROHM ROHM SOT-23	  RQ5A030AP ROHM RQ5A030AP ROHM
  RQ5A040ZPTR ROHM RQ5A040ZPTR ROHM	  RQ5C020PTL ROHM ROHM SMD	  RQ5A020ZPTR ROHM RQ5A020ZPTR ROHM	  RQ5A040ZP ROHM RQ5A040ZP ROHM

Más

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
 AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
 Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited